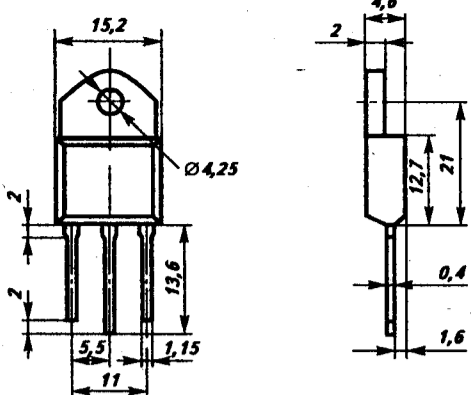


□ КТ886А1, КТ886Б1, КТ886А1-5, КТ886Б1-5

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p переключаемые, высоковольтные. Предназначены для применения в генераторах строчной развертки видеомодулей с повышенной информационной емкостью, источниках вторичного электропитания. КТ886А1, КТ886Б1 выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, тип корпуса КТ-43В-2. Масса транзистора не более 6 г. КТ886А1-5, КТ886Б1-5 выпускаются в бескорпусном исполнении с контактными площадками, без кристаллодержателя, без выводов, на общей пластине, кристаллы неразделенные. Масса транзистора не более 0,003 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 5 В, I_k = 4 А, T = +25^{\circ}С$	6...12*...25
Граничное напряжение при $I_k = 0,1 А, L_k = 25 мГн$, не менее	
КТ886А1, КТ886А1-5	700 В
КТ886Б1, КТ886Б1-5	500 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 4 А, I_о = 1 А$, не более:	
$T_k = +25^{\circ}С$:	
КТ886А1, КТ886Б1	1 В
КТ886А1-5, КТ886Б1-5	2,3 В
$T_k = +100^{\circ}С$:	
КТ886А1, КТ886Б1	2 В
$T = -10^{\circ}С$:	
КТ886А1, КТ886Б1	3,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 4 А, I_о = 1 А, T_k = +25^{\circ}С$, не более	
КТ886А1, КТ886Б1	1,5 В
Время рассасывания при $U_{кз} = 500 В, I_k = 4 А, I_о = 0,5 А, U_{об} = -5 В, L = 1 мГн$	1,7...2,5*...3,5 мкс
Время спада при $U_{кз} = 500 В, I_k = 4 А, I_о = 0,5 А, U_{об} = -5 В, L = 1 мГн$	0,12...0,2*...0,3 мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кз} = 100 В, f = 1 МГц$, не более	135 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{об} = 6 В, f = 1 МГц$, не более	7000 пФ
Модуль коэффициента передачи тока по высокой частоте при $U_{кз} = 25 В, I_k = 2 А, f = 3 МГц$	3,5...4,2*...5,2
Обратный ток коллектора при $U_{кз} = 1000 В$, не более:	
при $T_k = +25^{\circ}С$:	
КТ886А1,	0,1 мА
КТ886Б1	0,5 мА
при $T_k = +100^{\circ}С$ и $T = -10^{\circ}С$	
КТ886А1	0,5 мА
КТ886Б1	1,0 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{об} = 10 Ом$, не более:	
$T_k = +25^{\circ}С$:	
КТ886А1, КТ886А1-5 при $U_{кз} = 1400 В$	0,5 мА
КТ886Б1, КТ886Б1-5 при $U_{кз} = 1000 В$	0,5 мА
$T_k = +100^{\circ}С$:	
КТ886А1 при $U_{кз} = 1400 В$	0,5 мА
КТ886Б1 при $U_{кз} = 1000 В$	0,5 мА
Обратный ток эмиттера при $R_{об} = 7 В$, не более	10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база¹:
 КТ886А1, КТ886А1-5 1400 В

КТ886Б1, КТ886Б1-5 1000 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер¹:

КТ886А1, КТ886А1-5 1400 В

КТ886Б1, КТ886Б1-5 1000 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 7 В

Постоянный ток коллектора 10 А

Импульсный ток коллектора 15 А

Постоянный ток базы 5 А

Импульсный ток базы 5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора² 75 Вт

Температура p-n перехода +150°C

Температура окружающей среды -10°C... $T_k = +100^{\circ}С$

¹При $T = 0...+100^{\circ}С$ для КТ886А1, КТ886А1-5 постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер 1400 В.

При $T = -10...0^{\circ}С$ для КТ886А1, КТ886А1-5 напряжение 1300 В.

²При $T_k = +25...+100^{\circ}С$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения

$$P_{к, макс} = (150 - T_k) / 1,67, \text{ Вт}$$

